

Список основных публикаций официального оппонента  
**Ильина Владимира Алексеевича**

1. D. Riedel, F. Fuchs, H. Kraus, S. V ath, A. Sperlich, V. Dyakonov, A. A.Soltamova, P. G. Baranov, V. A. Ilyin, and G. V. Astakhov. Resonant Addressing and Manipulation of Silicon Vacancy Qubits in Silicon Carbide// Physical review letters, 109 (22), 226402, (2012).
2. П.А. Иванов, Н.Д. Ильинская, А.С. Потапов, Т.П. Самсонова, А.В. Афанасьев, В.А. Ильин. «Влияние быстрой термообработки на вольт-амперные характеристики 4H-SiC-диодов с барьером Шоттки». //Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, вып. 1, С.83 – 86.
3. A.V. Afanasyev, V.A. Ilyin, V.V. Luchinin, A.S. Petrov. «Electron Transport Features in Heterostructures 3C-SiC(n)/Si(p) at the Elevated Temperatures»// Materials Science Forum Vols. 740-742 (2013) pp. 498-501.
4. A. V. Afanasyev, B. V. Ivanov, V. A. Ilyin, A. F. Kardo-Sysoev, M. A. Kuznetsova, V. V. Luchinin. «Superfast drift step recovery diodes (DSRDs) and vacuum field emission diodes based on 4H-SiC»// Materials Science Forum Vols. 740-742 (2013) pp. 1010-1013.
5. А.И. Михайлов , А.В. Афанасьев , В.А. Ильин , В.В. Лучинин, С.А. Решанов М. Krieger , A. Sch oner , T. Sledziewski. «Ионная имплантация фосфора как метод пассивации состояний на границе раздела 4H-SiC и SiO<sub>2</sub>, полученного термическим окислением в атмосфере сухого кислорода» //Физика и техника полупроводников, 2014, том 48, вып. 12, С.1621 – 1625.
6. A. V.Afanasyev, B. V. Ivanov, V. A. Ilyin, A. F. Kardo-Sysoev, V. V. Luchinin, S.A.Reshanov, A. Schoner, A.A.Smirnov. Temperature dependence of minority carrier lifetime in epitaxially grown p+-p- -n+ drift step recovery diodes. Material Science Forum, v.821-823 (2015), p.p.632-635